

**Programma Operativo 2014-2020**

**Fondo Europeo di Sviluppo Regionale**

**- FESR -**

**DICHIARAZIONE DEI REQUISITI**

**LOTTO 3: SISTEMA ICP-PECVD**

**(Inductively Coupled Plasma - Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition System)**

Il presente documento riassume le specifiche dell’apparecchiatura descritte nel Capitolato Speciale - parte tecnica.

Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dell’offerta tecnica, il Concorrente dovrà compilare le sottostanti tabelle.

(riferimento: Capitolato speciale parte tecnica e Relazione tecnica dell’Offerente)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rif. requisito in Capitolato | Rispondenza | Riferimenti a paragrafi relazione tecnica | Eventuali note dell’Offerente |
| Caratteristiche tecniche e funzionali minime del sistema | | | |
| 2.1.1 | □ SI |  |  |
| 2.1.2.a | □ SI |  |  |
| 2.1.2.b | □ SI |  |  |
| 2.1.2.c | □ SI |  |  |
| 2.1.2.d | □ SI |  |  |
| 2.1.2.e | □ SI |  |  |
| 2.1.2.f | □ SI |  |  |
| 2.1.2.g | □ SI |  |  |
| 2.1.3 | □ SI |  |  |
| Caratteristiche tecniche e funzionali minime dei componenti | | | |
| Camera di processo | | | |
| 2.2.1.1 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.2 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.3 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.3 | □ SI |  |  |
| 2.2.1.4 | □ SI |  |  |
| Gas box con Mass Flow Controller (MFC) | | | |
| 2.2.2.1 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.2 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.3 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.4 | □ SI |  |  |
| 2.2.2.5 | □ SI |  |  |
| Sistema di pompaggio | | | |
| 2.2.3.1 | □ SI |  |  |
| 2.2.3.2 | □ SI |  |  |
| 2.2.3.3 | □ SI |  |  |
| Sistema di manipolazione delle fette (Load Lock & Substrate Handling System) | | | |
| 2.2.4.1 | □ SI |  |  |
| 2.2.4.2 | □ SI |  |  |
| 2.2.4.3 | □ SI |  |  |
| 2.2.4.4 | □ SI |  |  |
| 2.2.4.5 | □ SI |  |  |
| 2.2.4.6 | □ SI |  |  |
| Sistema di controllo di apparecchiatura e processo | | | |
| 2.2.5.1 | □ SI |  |  |
| 2.2.5.2 | □ SI |  |  |
| 2.2.5.3 | □ SI |  |  |
| 2.2.5.4.a | □ SI |  |  |
| 2.2.5.4.b | □ SI |  |  |
| 2.2.5.4.c | □ SI |  |  |
| 2.2.5.4.d | □ SI |  |  |
| 2.2.5.4.e | □ SI |  |  |
| 2.2.5.4.f | □ SI |  |  |
| 2.2.5.4.g | □ SI |  |  |
| 2.2.5.5 | □ SI |  |  |
| Caratteristiche migliorative | | | |
| 3.1a | □ SI - □ NO |  |  |
| 3.1b | □ SI - □ NO |  |  |
| 3.1c | □ SI - □ NO |  |  |
| 3.2 | □ SI - □ NO |  |  |
| 3.3 | □ SI - □ NO |  |  |
| 3.4 | □ SI - □ NO |  |  |
| 3.5 | □ SI - □ NO |  |  |

Parametri per figure di merito:

Il Concorrente deve compilare la tabella con i parametri delle ricette (# 1-4) nelle caselle evidenziate in giallo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabella 1 | | | | | | | | |
| Film Type | Reci. | Dep Rate  (DR) | Thickness | Refractive Index  (RI) | Wafer Level RI Uniformity  (URI) | Wafer Level Thickness Uniformity  (U) | Wet Etch Rate  (ER) | Breakdown Voltage |
| # | nm/min | nm | # | % | % | nm/min | MV/cm |
| Parametro |  | Impostato | Impostato | Misurato | Misurato | Misurato | Misurato | Misurato |
| Condizioni |  |  |  | @ 633 nm @ T < 150 C | +/-1 sigma @ T = 150 C | | BHF 10:1 |  |
| SiO2 low dep rate | 1 | 15 | 100 |  |  |  |  |  |
| SiO high dep rate | 2 | 30 | 300 |  |  |  |  |  |
| Si3N4low dep rate | 3 | 15 | 100 |  |  |  |  |  |
| Si3N4high dep rate | 4 | 30 | 300 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabella 2 | | | | | |
| Film Type |  | Dep Rate  (DR) | Temp. | Thickness | Stress Control |
| Recipe | nm/min | C | nm | MPa |
| Parametro | # | Impostato | Impostato | Impostato | Misurato |
| SiO low dep rate | 5 | 15 | 150 | 50 |  |
| SiO high dep rate | 6 | 30 | 150 | 300 |  |
| SiN low dep rate | 7 | 15 | 150 | 50 |  |
| SiN high dep rate | 8 | 30 | 150 | 300 |  |